

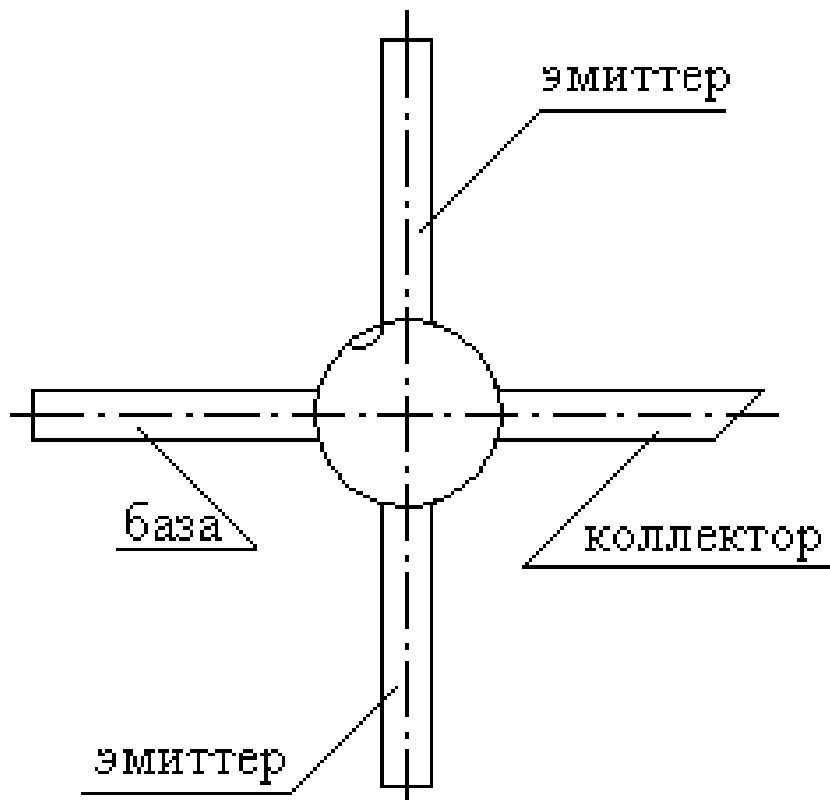
## ТРАНЗИСТОР 2Т3101А-2

Кремниевый бескорпусной планарно-эпитаксиальный

n-p-n транзистор 2Т3101А-2 на керамическом кристаллодержателе

с гибкими полосковыми выводами, предназначенный для применения в усилительных устройствах.

### Схема расположения выводов



## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

при  $t = (25 \pm 10) \text{ }^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Норма	
	не менее	не более
Обратный ток эмиттера, мкА ( $U_{ЭБ} = 4 \text{ В}$ )	35	300
Обратный ток коллектора, мкА (УКБ = 15 В)	-	0,5
Обратный ток эмиттера, мкА ( $U_{ЭБ} = 2,5 \text{ В}$ )	-	1
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте (УКБ = 5 В, $I_{Э} = 10 \text{ мА}$ , $f = 3 \cdot 10^8 \text{ Гц}$ )		–
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, пс (УКБ = 5 В, $I_{Э} = 5 \text{ мА}$ , $f = 3 \cdot 10^7 \text{ Гц}$ )	13,3	-
Коэффициент шума, дБ (УКБ = 5 В, $I_{Э} = 5 \text{ мА}$ , $f = 2,25 \cdot 10^9 \text{ Гц}$ , RГ – оптимальное по КШ)	-	10
Коэффициент усиления по мощности, дБ (УКБ = 5 В, $I_{Э} = 10 \text{ мА}$ , $f = 2,25 \cdot 10^9 \text{ Гц}$ , RГ – оптимальное по КУР)	6	–
Емкость коллекторного перехода, пФ (УКБ = 5 В, $f = 10^7 \text{ Гц}$ )	-	1,5
Емкость эмиттерного перехода, пФ ( $U_{ЭБ} = 1 \text{ В}$ , $f = 10^7 \text{ Гц}$ )	–	2,5